

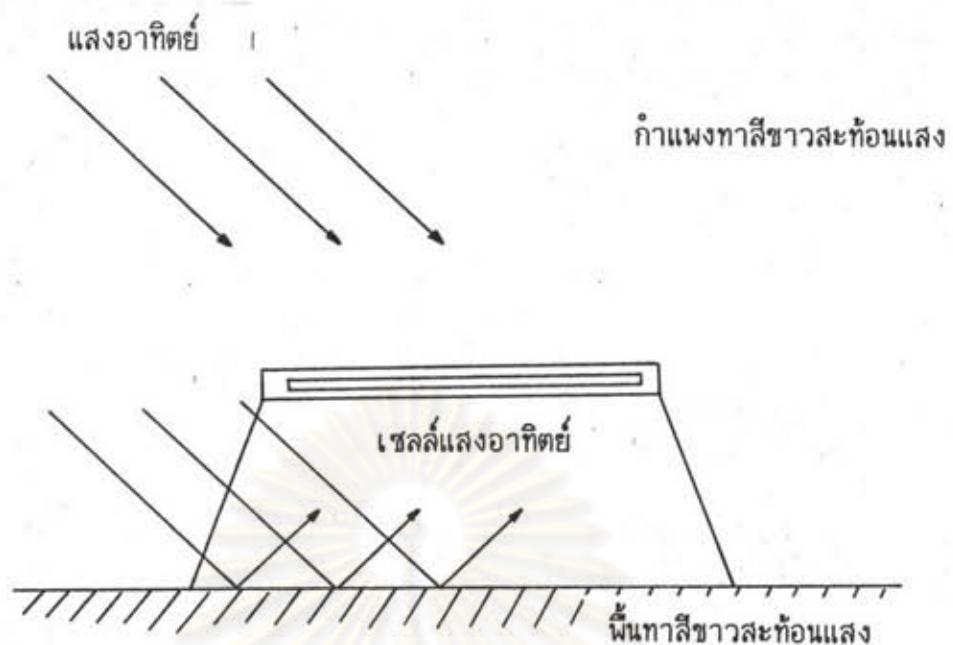
## บทที่ 6

### สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

#### 6.1 สรุปผลการทดลอง

การสร้างเชลล์แสงอาทิตย์แบบ SC2AA ได้ผลดีพอใช้คือ ค่ากำลังไฟฟ้าข้าอกมิค่า ประมาณ 1.6 เท่า เมื่อเทียบกับเชลล์แสงอาทิตย์แบบ CSC ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า กำลังไฟฟ้าข้าอกมิค่าอยู่ระหว่าง 1 - 2 เท่า และควรจะมีค่าสูงกว่านี้ถ้ามีการออกแบบหน้ากากสำหรับการแพร่รัมและหน้ากากสำหรับการทำข้าวโพดที่ดีกว่านี้ เนื่องจากหน้ากากที่ออกแบบมาในนี้ มีขนาดโดยพื้นที่ผู้วิจัยสามารถทำการปรับแต่ง ( Alignment ) ได้ง่าย ซึ่งอาจมีขนาดที่เหมาะสมมากกว่านี้

ผลการทดลองสร้างเชลล์แสงอาทิตย์แบบ SC2AA นี้พบว่าผลที่ได้ยังไม่คุ้มกับการสร้าง เพราะว่าเชลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพสูงไม่พอ เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของเชลล์แบบ CSC ( ถ้าคิดเทียบกับพื้นที่ทึบหมุดโดยไม่หักข้าวโพด ) แม้ว่าจะมีบางตัวมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงก็ตาม รวมทั้งการสร้างมีขั้นตอนลับขั้นกว่าเชลล์แสงอาทิตย์แบบ CSC มากทำให้ใช้เวลาการสร้างเชลล์แสงอาทิตย์แต่ละตัวกินเวลานานขึ้นและสารเคมีเบล็อกเพิ่มขึ้น ด้านทุกการผลิตซึ่งสูงขึ้นตามที่ผู้วิจัยได้ระบุไว้ และผลการทดลองในรูปที่ 5.22 แสดงให้เห็นว่า เชลล์แสงอาทิตย์แบบ CSC ที่มีกราะจะละห้อนแสงวางทำมุม  $60^\circ$  มีค่ากระแสงไฟฟ้าลัดวงจรสูงกว่า เชลล์แสงอาทิตย์แบบ SC2AA ที่มีกราะจะละห้อนแสงวางทำมุม  $45^\circ$  ซึ่งเป็นการยืนยันว่าถ้ามีการใช้งานในลักษณะนี้ผลที่ได้ไม่คุ้มกับการสร้างแน่นอน เนื่องจากการสร้างเชลล์แสงอาทิตย์แบบ SC2AA มีขั้นตอนลับขั้นกว่า แต่ถ้านำเชลล์แสงอาทิตย์แบบ SC2AA มาใช้งานแบบเดียวกับเชลล์แสงอาทิตย์แบบ CSC และที่พื้นทางด้านหลังสามารถจะห้อนแสงได้โดยไม่ใช้กราะจะละห้อนแสงช่วยดังรูปที่ 6.1 พบว่ามีกระแสงไฟฟ้าลัดวงจรเพิ่มขึ้น ซึ่งค่ากระแสงไฟฟ้าลัดวงจรที่เพิ่มขึ้นมาในนี้มีค่าเปลี่ยนไปตามระยะทางระหว่างเชลล์แสงอาทิตย์กับพื้นผิวที่จะห้อนแสง ถ้าระยะห่างน้อยกระแสงไฟฟ้าลัดวงจรจะค่ามาก ดังนั้นถ้ามีการใช้งานลักษณะนี้ผลที่ได้น่าจะคุ้มค่ามากกว่า



รูปที่ 6.1 เชลล์แสงอาทิตย์แบบ SC2AA ที่มีการใช้งานแบบเดียวกับเชลล์แสงอาทิตย์แบบ CSC

ผลการทดลองสามารถนำมาสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้คือ

1. จากการทดลองเมื่อมีการต่อเชลล์แสงอาทิตย์ในลักษณะนี้กัน พบว่าส่วนใหญ่ของค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  $V_{oc}$ , FF, ฯ จะมีค่าอยู่ระหว่างเชลล์แสงอาทิตย์ที่วัดจากทางด้านหน้าและด้านหลัง เช่น  $V_{oc}$  วัดทางด้านหน้าได้ 0.529 V. วัดทางด้านหลังได้ 0.509 V. วัดเมื่อต่อลักษณะนี้กันได้ 0.517 V., FF วัดทางด้านหน้าได้ 0.54 วัดทางด้านหลังได้ 0.56 วัดเมื่อต่อลักษณะนี้กันได้ 0.55 และ ฯ วัดทางด้านหน้าได้ 6.56 % วัดทางด้านหลังได้ 5.53 % วัดเมื่อต่อลักษณะนี้กันได้ 6.39 % เป็นต้น

2.  $I_{sc}$  ที่เกิดจากการต่อเชลล์แสงอาทิตย์ในลักษณะนี้กันไม่ได้เกิดจากการนำเอา  $I_{sc}$  ทางด้านหน้า  $I_{sc}$  ทางด้านหลัง เมื่อมีการฉายแสงทั้งด้าน รวมกับ  $I_{sc}$  ที่เกิดจากการฉายแสงเข้าทางด้านลึกของหัวต่อแล้ววัดอิกด้านหนึ่ง ดังสมการที่ 6.1 แต่เกิดจาก  $I_{sc}$  ที่เกิดจากการฉายแสงเข้าทางด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกันแล้ววัดทางด้านหน้า รวมกับ  $I_{sc}$  ที่เกิดจากการฉายแสงเข้าทางด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกันแล้ววัดทางด้านหลัง ดังสมการที่ 6.2

$$I_{sc} \text{ ฐาน } = I_{sc} \text{ หน้า} + I_{sc} \text{ หลัง} + I_{sc1} + I_{sc2} \quad (6.1)$$

เมื่อ  $I_{sc}$  หน้า คือ กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่วัดทางด้านหน้า เมื่อมีการฉายแสงเข้าทางด้านหน้า  
 $I_{sc}$  หลัง คือ กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่วัดทางด้านหลัง เมื่อมีการฉายแสงเข้าทางด้านหลัง  
 $I_{sc1}$  คือ กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่วัดทางด้านหน้า เมื่อมีการฉายแสงเข้าทางด้านหลัง  
 $I_{sc2}$  คือ กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่วัดทางด้านหลัง เมื่อมีการฉายแสงเข้าทางด้านหน้า

$$I_{sc} \text{ ขนาด } = I_1 + I_2 \quad (6.2)$$

เมื่อ  $I_1$  คือ กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่เกิดจากการฉายแสงเข้าทางด้านหน้าและด้านหลัง  
 พร้อมกับแล้ววัดทางด้านหน้า  
 $I_2$  คือ กระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่เกิดจากการฉายแสงเข้าทางด้านหน้าและด้านหลัง  
 พร้อมกับแล้ววัดทางด้านหลัง

โดยที่

$$I_1 > I_{sc} \text{ หน้า} + I_{sc1}$$

$$I_2 > I_{sc} \text{ หลัง} + I_{sc2}$$

3. เงื่อนไขการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์พบว่าในการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบ SC2AA โดยใช้แวนเพล็กที่มีความต้านทานจำเพาะ  $0.1 - 0.2 \Omega \cdot \text{cm}$  การแพร่รัมด้วยเวลา  $5' + 15' + 5'$  นาที แล้วกัดซิลิโคนให้ได้ค่าความต้านทานแผ่น (Sheet Resistance)  $\approx 20 - 30 \Omega/\square$  จะให้ค่า  $I_{sc}$  ค่อนข้างสูงและยังคงมีค่าไฟล์แฟกเตอร์ที่มีค่าสูงอย่างคง  
ยอมรับได้ เซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการทดลอง

4. ในการคำนวณหาค่าประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์นี้จะต้องหักพื้นที่ส่วนที่เป็นชั้นพื้นออกด้วย เนื่องจากอิเล็กตรอน-โลลที่เกิดขึ้นเมื่อมีการฉายแสงนี้มีบางส่วนรวมตัวไปหมด ก่อนที่จะถึงชั้นโลหะซึ่งไม่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า

5. การที่จะสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบ SC2AA ให้มีประสิทธิภาพดีเท่ากับเซลล์แสงอาทิตย์แบบ CSC นั้นเป็นไปได้ยากสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจาก Single Crystal หรือ Polycrystalline เนื่องจากพื้นที่ทำงานจะน้อยกว่า เพราะมีชั้นโลหะบนพื้นเพิ่มขึ้นมา แต่อาจเป็นไปได้ในเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีชั้นโลหะแบบโปร่งใส

6. เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีโครงสร้างแบบที่ 6 จะมีค่า  $I_{sc}$  สูงกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีโครงสร้างแบบที่ 5 เนื่องจากมีพื้นที่ทำงานมากกว่า

7. ค่าความต้านทานอนุกรมในแนวราบ ( Lateral Resistance ) มีค่าค่อนข้างสูงประมาณ 1-2 Ω ( สำหรับเชลล์ที่มีคุณภาพค่อนข้างดี ) ซึ่งมีค่าน้อยพอที่จะยอมรับได้เนื่องจากไม่ไปลดค่าประสิทธิภาพของเชลล์ลงมากนัก

8. ปัญหาที่เกิดในการประดิษฐ์เชลล์ลงอาทิตย์ล้วนใหญ่จึงเกิดในขั้นตอนการซุบนิกเกิลและบัดกรีต่อสาย จำเป็นต้องใช้น้ำยาที่ใหม่ในการซุบทุกครั้งจึงจะทำให้นิกเกิลติดตื้น และการเลือกใช้ฟลักซ์ที่ใช้สำหรับบัดกรีต้องเลือกให้มีคุณภาพที่ค่อนข้างดี การบัดกรีจึงทำได้ง่าย

9. เพื่อที่จะหาสาเหตุที่เชลล์ลงอาทิตย์มีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำจึงนำเอาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในตารางที่ 5.1 - 5.18 แทนลงในสมการที่ 2.13 เพื่อหาค่า  $I_{ph}$  ซึ่งตั้งสมมุติฐานไว้ว่าถ้า  $I_{ph}$  มีค่าไม่แตกต่างกับ  $I_{sc}$  มากนักแสดงว่าค่า  $R_s$  ไม่ใช่เป็นตัวลดประสิทธิภาพของเชลล์ฯ ซึ่งจากการแทนค่าพารามิเตอร์ต่างๆ แล้วพบว่าค่า  $I_{ph}$  มีค่าแตกต่างจาก  $I_{sc}$  มากอยู่ในช่วงประมาณ 10 - 100 เท่ากันทุกตัว ดังนั้นค่า  $R_s$  ควรจะเป็นตัวที่ลดประสิทธิภาพของเชลล์ฯ แต่เมื่อลองพิจารณาค่า  $R_s$  ในตารางแล้วพบว่าค่า  $R_s$  มีค่าค่อนข้างต่ำพอที่จะไม่ไปลดประสิทธิภาพมากนัก ซึ่งแสดงว่าอาจมีการวัดข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งผิดพลาดและเมื่อลองเปลี่ยนค่า  $I_{o1}$  ให้มีค่าน้อยลงและหรือเปลี่ยนค่า  $g_1$  ให้มีค่าสูงขึ้นพบว่า  $I_{ph}$  มีค่าใกล้เคียงกับค่า  $I_{sc}$  ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าข้อมูลที่วัดมานี้ผิดพลาดจากความเป็นจริง ทั้งนี้เนื่องจากการวัด  $I_{o1}, I_{o2}, g_1, g_2$  นั้นทำได้ยาก เพราะข้อมูลไม่ต่อเนื่อง ส่วนการวัดค่า  $R_s, R_{sh}$  ค่อนข้างเชื่อถือได้มากกว่า ดังนั้นจึงยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสาเหตุที่เชลล์ฯ มีประสิทธิภาพต่ำนั้นเนื่องจากอะไรเหตุใด

## 6.2 ข้อเสนอแนะ

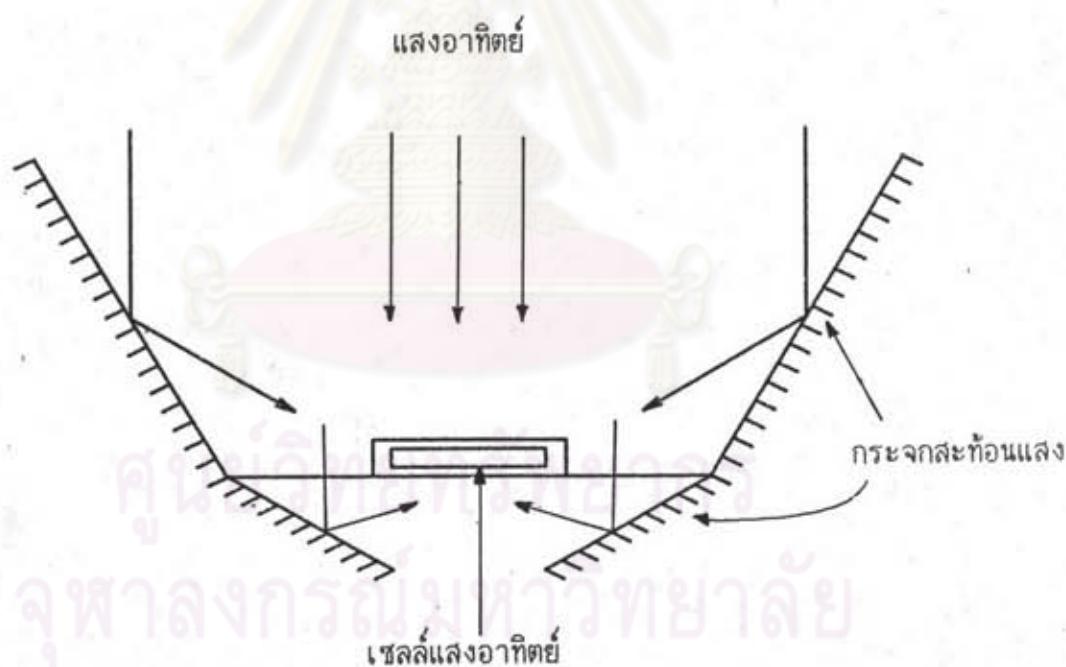
1. ถ้าเลือกใช้วัสดุพลิกที่มีความต้านทานจำเพาะใกล้กับ 1 Ω-cm ผลที่ได้ควรจะมีค่าติดกันนี้ ซึ่งโดยทั่วไปเชลล์ลงอาทิตย์จะมีประสิทธิภาพสูงที่ค่าความต้านทานจำเพาะ 1 Ω-cm แต่เนื่องจากห้องปฏิบัติการวิจัยสารกึ่งตัวนำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่มีค่าที่ใกล้เคียงให้เลือกใช้จำเป็นต้องใช้ค่าประมาณ 0.1 Ω-cm

2. การใช้วิธี Lift off ในขั้นตอนการทำเข็วโลหะนี้ไม่ต้องทำการอบ 120 °C หลังจากทำการ Develop แล้วเนื่องจากจะทำให้น้ำยาไวแสงแข็งตัวเกินไปซึ่งเมื่อกำรสบายน้ำโลหะแล้วทำให้ล้างไม่ออกและอาจทำให้โลหะที่ล้างไปหลุดออกมาด้วย

3. ถ้ามีการปรับปรุงการแพร่รัมให้ดีขึ้นคือสามารถควบคุมความลึกของหัวต่อและความเร็วขันที่ผิวได้เชลล์แสงอาทิตย์จะมีประสิทธิภาพกว่านี้แน่นอน เนื่องจากผลการทดลองบ่งถึงค่าความลึกของหัวต่อมีค่าน้อยและต้องมีลักษณะที่เป็นการโดปอย่างหนัก ( Heavily dope ) เชลล์แสงอาทิตย์ที่ได้จะมีประสิทธิภาพสูง

4. ถ้าช่องมองภาพของเครื่องถ่ายแบบหน้ากากลงบนแร่เพล็กมอน ได้ชัดกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้ จะสามารถทำให้ออกแบบหน้ากากในการทำข้าวไลหะและการแพร่รัมมีรายละเอียดดีกว่านี้

5. จากการทดลองพบว่า เชลล์แสงอาทิตย์แบบ CSC ที่มีกระเจกะลหัวแหลมทำมุม  $60^\circ$  จะให้กำลังไฟฟ้าใกล้เคียงกับ เชลล์แสงอาทิตย์แบบ SC2AA ดังนั้นถ้าลองเปลี่ยนการติดตั้งเชลล์แสงอาทิตย์แบบ SC2AA ให้วางในแนวอนและมีกระเจกะลหัวแหลมทำมุม  $60^\circ$  ทางด้านหน้าและทางด้านหลังวางกระเจกะลหัวแหลมทำมุม  $30^\circ$  ดังรูปที่ 6.2 น่าจะให้กำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกมาก



รูปที่ 6.2 เชลล์แสงอาทิตย์แบบ SC2AA วางในแนวอนและมีกระเจกะลหัวแหลม 2 คู่